# 一种新的纳米结构——管状石墨锥\*

### 张广宇 王恩哥<sup>†</sup>

(中国科学院物理研究所表面物理国家重点实验室 中国科学院国际量子结构中心 北京 100080)

摘 要 文章作者利用微波等离子体辅助化学气相沉积的方法在铁针尖上合成了一种新的纳米结构,并称之为 管状石墨锥.管状石墨锥在外形上由多面锥体组成,其内部是同心的圆柱形石墨层,其空心的直径为几个纳米到 几十个纳米.这些管状石墨层从内到外地逐渐变短,从而使得它们呈现出锥形外观.锥的顶角一般为6—7度左右, 锥的尖端只有几个纳米大小,而锥的底部可达到微米量级.值得注意的是,组成管状锥体的石墨层具有惟一的手 性,都表现为锯齿型.

关键词 管状石墨锥 类碳纳米管 螺旋性 , 微波等离子体化学气相沉积

### A novel nanostructure—tubular graphite cones

ZHANG Guang-Yu WANG En-Ge<sup>†</sup>

( State Key Laboratory for Surface Physics and International Center for Quantum Structures , Institute of Physics , Chinese Academy of Sciences , Beijing 100080 , China )

**Abstract** We report the synthesis of tubular graphite cones using a chemical vapor deposition method. The cones have nanometer size tips, micrometer size roots and hollow interiors with a diameter ranging from about 2 to several tens of nanometers. The cones are composed of cylindrical graphite sheets; a continuous shortening of the graphite layers from the interior to the exterior makes them cone-shaped. All of the tubular graphite cones have the faceted morphology and all of the constituent graphite sheets have identical chiralities of zigzag types across the entire diameter, thus structural control for tubular based carbon structures has been achieved. The tubular graphite cones have potential use as tips for scanning probe microscopy, but with greater rigidity and easier mounting than currently used carbon nanotubes.

Key words tubular graphite cones , carbon nanotubes , chirality , microwave CVD

寻求新的纳米结构并探讨其物理特性是近年来 许多学科的研究热点之一.其中最具代表性的新结 构就是碳纳米管<sup>[1]</sup>.由于碳纳米管具有特殊的原子 结构和优越的机械性能,它在扫描探针显微技 术<sup>[2-4]</sup>、场发射<sup>[5-7]</sup>、纳米器件和操作<sup>[8]</sup>等许多方面 有着广泛的应用前景.利用其内部是空管的特点,可 以将金属、氧化物、半导体等材料进行填充,从而获 得一维纳米线<sup>[9-12]</sup>.同时为了改变和控制纳米管的 性质,人们在纳米管的掺杂方面也进行了大量的研 究,并获得了氮掺杂碳纳米钟<sup>[13]</sup>,硼碳氮纳米 管<sup>[14]</sup>和纳米管异质结<sup>[15]</sup>等结构.另外还发现纳米 管亦可作为气体、液体和小分子无机物的纳米传输 管道. 更有趣的是,由于受到量子限域效应的作用, 这些体系会表现出新的物理现象. 最近研究已经表 明,碳纳米管里的水、蛋白质和其他气体会表现出不 同于三维体相的独特性质<sup>[16-18]</sup>.

大家知道,碳纳米管的管壁是由同心的圆柱形

† 通讯联系人. E-mail :egwang@ aphy. iphy. ac. cn

 <sup>\*</sup> 国家自然科学基金(批准号:10134030,60021403)、国家重点基
 础研究发展计划(批准号:G2000067103)和国家高技术研究发展计划(批准号2002AA311150)资助项目
 2003-05-29 收到

石墨层套构而成,石墨层的层间距是 0.34nm. 圆柱 形石墨层可以看成是由平面石墨层闭合地卷曲而 成. 石墨层内的碳原子排成六元环的网格, C---C 键是 sp<sup>2</sup> 杂化的,所以碳纳米管轴向上的机械强度 很好[19]. 然而,由于它的直径非常小(直径上下一样 粗 通常在 100nm 以下 ),而长度非常大(可以达到 毫米量级)即它的纵横比非常高(可以达到105量 级),所以径向比较柔韧易弯.这种径向的柔韧性对 于某些应用会产生一些问题. 例如 在场电子发射器 件和扫描探针显微学等应用方面,径向的机械震动 和热震动会导致信号减弱并同时引起噪音. 特别是 作为扫描探针要获得原子分辨的图像时,往往要求 碳纳米管的直径更细,这样一来噪音也会加大.另 外 如果要把碳管用做纳米尺寸的钻头和压头 那么 更要求它的径向要有很好的机械强度和稳定性. 最 近 我们在多年利用微波等离子体辅助化学气相沉 积方法从事纳米管制备研究的基础上[7,12-15,18],以 铁针尖作为基底合成了一种新的纳米材料,并称之 为管状石墨锥(见图1).这种新的管状石墨锥结构 在径向上具有很高的机械强度和稳定性,从而成功 地解决了上述难题<sup>[20]</sup>.

管状石墨锥的合成是在微波等离子体辅助化学 气相沉积系统上实现的. 这里我们用氮气和甲烷作 为反应气体,用铁针尖作为基底. 铁针尖是用电化学 方法腐蚀铁丝(直径 0.25mm)做成的,通常尖部的 曲率半径不超过 1μm. 在生长之前,把铁针尖竖插 在有孔的石墨台上,使针尖在生长过程中正对等离 子体. 在生长时,控制石墨台的温度在 600℃左右, 反应气压为 15Torr(1Torr = 133.332Pa),微波功率 为 750W.

实验发现,所有管状石墨锥都是直接从铁针尖 基底表面生长起来的,而且形状基本相似.实验中 在锥的尖部我们没有观察到催化剂颗粒,这表明管 状石墨锥的生长采取了底部生长模式.图1(a)给出 的是经过30min生长后获得的管状石墨锥的扫描电 镜照片.从图中我们可以看出,锥的平均长度大约是  $12\mu$ m,平均顶角为6°—7°,底部直径达到了1 $\mu$ m 左 右.样品中锥的尖部直径从几纳米到几十纳米不等. 锥的形状是在生长过程中由轴向生长速率 $R_a$  和径 向生长速率 $R_r$ 控制的.在我们的实验中, $R_a/R_r$ 近 似是一个常数.对于碳纳米管来说,由于没有径向的 生长速率,所以 $R_r = 0$ .通过控制生长时间,我们可 以控制管状石墨锥的长度和底部大小.实验观察到 的最小的锥长度不到1 $\mu$ m 根部尺寸在20nm 左右. 另外从高分辨率的扫描电镜照片[见图1(b)]可以 看出,管状石墨锥的外表面不是圆锥体,而是由多 棱形螺旋状的锥体组成.大量的实验发现,大部分这 种石墨锥的表面具有八面体形状.锥的螺旋方向是 随机的(顺时针和逆时针旋转的比率大约是1:1), 但是每个锥的螺旋角是不同的.



图 1 扫描电子显微镜和透射电子显微镜像 (a)铁针尖表面生长的定向管状石墨锥;(b)单根锥的高分辨率 像;(c)锥尖的高分辨透射电镜像.锥表面的石墨层的台阶清晰 可见

电子能量损失谱(场发射 2010 透射电镜,GIF, Gatan,US)的结果中除了碳的峰外,没有其他的信 号存在.不考虑设备的灵敏度(探测到信号的极限 大约是1%)和材料表面的悬键可能会吸附H原子, 我们可以认为,样品的成分只含有碳.从高分辨透射 电子显微照片中我们可以看到,锥的中心是个空管, 它的直径分布在2到几十纳米之间.锥尖通常只有 少数几层石墨层,顶部以圆顶形的或者是锥形的石 墨层封口.管状石墨锥的微结构与碳纳米管十分相 似,也是由共轴的圆柱形石墨层构成,但是不像碳纳 米管那样所有的层都是等长的,锥的石墨层由内向 外逐渐变短,构成锥形结构[见图1(c)].微米尺寸 的石墨圆锥以前有过报道<sup>[21]</sup>,它们是由圆锥形的石 墨层套构而成,结构和我们的结果完全不一样.

我们从实验中获得的所有的管状石墨锥表面都 具有多棱体的形貌[见图 1(b)],这使我们联想到 它的石墨层是否也具有多面体的形状<sup>[22 23]</sup>.然而, 在成像的时候,我们一边转动样品(样品可以沿X,Y 两个方向转动)一边拍摄它的高分辨像照片,我们 会发现总是可以得到条纹状的晶格像.如果石墨层 具有多面体的形状,那么只有在透射电子束和多面 体的某一个面平行的时候才会有高分辨像出现.所 以石墨层和高分辨透射电子显微镜的研究结果显示

出所有的层都是圆柱形的. 锥表面的多棱形貌只能 由柱状的石墨层的开口边缘形状决定. 如果每个柱 状石墨层是以圆形开口的,锥的表面应该是光滑的 圆锥形.而这里我们得到的管状石墨锥表面的多棱 形貌是由石墨层的开口边缘的不规则引起的. 仔细 研究发现 开口边缘是锯齿状的 所有石墨层的开口 边缘的齿突构成了锥体表面上的棱. 在低分辨透射 电子显微镜的欠焦像中 我们可以观察到沿锥的轴 线方向存在一系列左右规律分布的暗点[见图2 (a)].我们推测,这些暗点是由于锥中存在不均匀 应力导致的.由于多棱锥不是轴对称的结构 根据前 面的讨论, 维棱相对于锥体来说可以看成是由附加 的石墨层构成的. 成像的时候, 当这些附加层准平行 于电子束从而参与成像的时候,应力就会导致相对 暗的对比度,考虑到锥的螺旋结构,暗点就会有规律 地左右分布.引起像中出现暗点的另外一个可能的 原因是石墨层中存在缺陷. 缺陷的存在也会使应力 分布不均匀 导致成像的对比度的不同.



图 2 透射电子显微镜像 (a)管状石墨锥;(b)锥尖

为了研究管状石墨锥的微观结构,我们采用高 分辨透射电子显微镜对它进行详细的分析.图 3(a) 是一张低倍像,图 3(b)(c)(d)(e)分别是图 3 (a)中 b,c,d,e区域的高分辨像.我们知道,碳纳米 管的晶格像是一系列的线状条纹.管状石墨锥则不 同,晶格像是一系列分立的点.相邻的点距 $d_1$ 大约 是 0.21 nm 相邻的层距 d 大约是 0.34 nm. 一层之 内的点和相邻层的点不是正对的而是沿层内方向上 相互错开 $d_1/2$ 的距离.这表明,层间是有序的.这种 像我们也可以在锥的顶部观察到[见图 2(b)].当 电子显微镜的透射电子束垂直于管轴的时候,锯齿 式管和扶手椅式管<sup>24</sup>[见图 4(a)]是两种典型的能 成分立点像的管.给定石墨层内 C—C 键长为 0.1421 nm,锯齿式管和扶手椅式管的高分辨透射像 的层内点距的计算值分别是 $d_1 = 0.213$  nm和 $d_2 =$ 



图 3 管状石墨锥的微结构 (a)低倍欠焦透射电子显微镜像.右上角和左下角的插图对应于 (a)中的方框区域 (b—e)是(a)中标为 b c d e 的区域的高分 辨像.图中的符号 d d<sub>1</sub> d<sub>3</sub> 的定义在图 4 中给出 ;(f)石墨锥侧 壁边缘选区电子衍射图案

0.123 nm. 我们的实验值 d<sub>1</sub> = 0.21 nm 和锯齿式管 的计算值符合得很好,而层间错开 d1/3 是由于层间 的 ABAB...石墨性有序排列造成的. 所有的层都具 有这样的特点说明 ,锥的所有的石墨层都具有全同 的螺旋性. 在锥的中心部,我们观察到了六角形的 像,条纹间距 d<sub>3</sub> 大约是 0.21 nm. 六角形的像通常 覆盖了锥的整个空心部分,也会与内部的石墨层产 生交齿 见图 3 (b)和(e)] 这种像和块状石墨沿 c 轴的透射像是一样的.沿 c 轴方向去看石墨层的一 个基本 AB 重复单元 见图 4(a)] 所有被原子占据 的位置可以分成两组:一组只有一个原子[图4(a) 中标圆圈的位置];而另一组有两个[图 4(a)中标 黑点的位置 1.那些标黑点的位置产生六角像 标圆 圈的位置由于原子少而作为背景.图 3(c)给出了锥 的外壁的高分辨像 ,它们和内侧的层具有相同的特 点. 对于管状石墨锥这种情况 尽管锥壁是由圆柱状 石墨层构成 但是以入射电子束为中线的圆柱形石 墨层沿轴线方向很窄的一条可以近似看成是平面, 在此区域仍然可以成六角形的像. 对于直径比较大 的地方 石墨层的曲率比较小 则更容易形成这种六 角形像 见图 3(e)],而且六角形像覆盖的区域也 不会完全正对 :另外 ,我们也很难使入射电子束完全 垂直于锥的轴线. 这是造成很难拍到分立的点状石 墨结构排列的两个因素.图 3(a)中锥体的左侧壁和 右侧壁的选区电子束衍射给出了相同的花样.图 3 (f)是一张比较典型的衍射图案,所选的锥的石墨层 是准平行于入射电子束的.(101 1)衍射斑是石墨性



图4 (a)一个石墨单层的示意图 *a*<sub>1</sub> 和 *a*<sub>2</sub> 是二维晶格的基 矢 *R* 是任意矢量 ,用(*m*,*n*)表征 ,一个(*m*,*n*)的管就是把平面 的石墨层卷曲成筒状 ,使(*m*,*n*)位置和原点重合 (*m*,*0*)和(*m*, *m*)的管分别称为锯齿式管和扶手椅式管 ;(b)锥壁的两个相邻 石墨层(一个 AB 单元)的模型. 图中的黑色区域可以近似看成 是平的

排列的典型标志.

我们用高分辨透射电子显微镜测量的组成管状 锥的石墨层层间距 *d* = 0.34nm,这与碳纳米管是一 样的<sup>[25]</sup>.在管内部,层数每增加一层,圆柱状石墨层 的周长就要增加2π*d*的长度.对于具有全同螺旋性 (锯齿式)的管状石墨锥,这意味着,每增加一层,石 墨层要比邻近的内部一层长 8—9 个碳的六元环 (假定 C—C 键长不变).为了保持石墨层的ABAB ...排列,或者局部的 sp<sup>2</sup>杂化的 C—C 键会有弛豫, 或者在石墨层内存在缺陷和位错,或者两种情况都 有.在管壁的内层,由于石墨层的直径比较小,包含 的碳六元环比较少,这种效应会更显著.

这项新的研究成果在国内外引起了广泛的重 视. 德国、英国和美国的学术媒体先后进行了大量的 报道. 专家认为,这是一种'新的奇特的类纳米管结 构". 管状石墨锥与普通的碳纳米管相比,一方面它 的锥体结构大大增强了其径向机械强度,另一方面 它的顶部尺寸在几个纳米以内,所以它是理想的扫 描探针的针尖和场发射材料. 同时我们正在利用它 制备纳米机械压头,从而准备开展纳米水平上的硬 度研究. 实现上述目标的一个重要原因是管状石墨 锥底部的尺寸可以控制到微米量级,因此可利用今 天的微加工技术进行直接操作.这是碳纳米管目前 所不能做到的.这项研究的另一个令人惊奇的地方 是,在这种管状石墨锥里所有的石墨层具有全同的 手性——锯齿型.这是人们第一次在一定意义上成 功地实现了对类纳米管手性的控制.

除了在扫描探针显微学、场电子发射器件和纳 米加工领域将会得到许多应用外,由于它的可操作 性也将会在生物和化学等领域有广泛的应用前景. 例如 利用管状石墨锥具有几个纳米到几十个纳米 左右的内径,可以作为储存和输运液态物质的通道. 甚至可以用它做成纳米注射器,从事纳米水平的细 胞修复和改性研究.为实现这些应用,进一步的研究 正在进行之中.

致谢 感谢德国夫琅合费研究所姜辛教授参与本文 结构方面的部分研究工作,感谢中国科学院物理研 究所沈峰博士和德国 Jülich、贾春林在电镜方面的 有益讨论与指导.

#### 参考文献

- [ 1 ] Iijima S. Nature , 1991 , 354 56
- $\left[ \begin{array}{c} 2 \end{array} \right] \ \ {\rm Dai} \ {\rm H} \ et \ al.$  Nature , 1996 , 384 :147
- [ 3 ] Hafner J H , Cheung C L , Lieber C M. Nature , 1999 , 398 : 761
- $\left[ \begin{array}{c} 4 \end{array} \right] \ \mbox{Wong S S } et \ al.$  Nature , 1998 , 394 52
- [5] Rinzler A G et al. Science, 1995, 269 :1550; Saito Y et al. Nature, 1997, 389 554
- [ 6 ] Fan S et al. Science , 1999 , 283 512
- [7] Zhi C Y, Bai X D, Wang E G. Appl. Phys. Lett. ,2002 ,81: 1690
- [ 8 ] Kim P , Lieber C M. Science , 1999 , 286 2148
- [ 9 ] Ajayan P M , Iijima S. Nature , 1993 , 361 333
- [10] Tsang S C et al. Nature , 1994 , 372 :159
- [11] Ugarte D , Châtelain A , Heer W A de. Science , 1996 , 274 : 1897
- [12] Zhang G Y , Wang E G. Appl. Phys. Lett. , 2003 , 82 :1926
- [ 13 ] Ma X et al. Appl. Phys. Lett. ,1999 ,75 3105 ; Ma X et al.
  Appl. Phys. Lett. ,2000 ,77 #136
- [ 14 ] Bai X D et al. Appl. Phys. Lett. , 2003 , 77 57 ; Zhi C Y , Bai X D , Wang E G. Appl. Phys. Lett. , 2002 , 80 3590
- [ 15 ] Ma X , Wang E G. Appl. Phys. Lett. ,2001 ,78 978 ; Guo J D et al. Appl. Phys. Lett. ,2002 ,80 :124
- [16] Koga K et al. Nature , 2001 , 412 802
- [ 17 ] Hummer G , Rasalah J C , Noworyta J P. Nature , 2001 , 414 : 188
- [18] Bai X D et al. Appl. Phys. Lett. , 2001 , 79 :1552 ; Zhong D Y et al. Appl. Phys. Lett. , 2001 , 79 3500

- [19] Treacy M M J, Ebbesen T W, Gibson J M. Nature, 1996, 381 678
- $\left[ \begin{array}{c} 20 \end{array} \right] \,$  Zhang G Y , Jiang X , Wang E G. Science , 2003 , 300 472
- [21] Krishnan A et al. Nature , 1997 , 388 451
- [22] Gogotsi Y et al. Science , 2000 , 290 317

- [23] Libera J , Gogotsi Y. Carbon , 2000 , 39 :1307
- [24] Hamada N , Sawada S , Oshiyama A. Phys. Rev. Lett. ,1992 , 68 1579
- [25] Saito Y et al. Phys. Rev. B , 1993 , 48 :1907

物理新闻与动态。

## 能攀登的原子 (Mountain-climbing atoms)

利用分子束外延方法在晶体表面沉积原子时,当基底的 温度很低时,在覆盖原子的表面上常会出现许多凹凸不平的 小丘,而不是光滑的平面.但对于较高温度的基底,在小丘顶 部的原子就会通过扩散向下移动到晶体的表面.按照传统的 理论,向上扩散的原子是可以忽略不计的.

近来,意大利 Genova 大学、中国科学院、美国橡树岭国 家实验室共同合作的研究组的科学家们(F. Buatier de Mongeot 和 Zhang Zhenyu 等)发现,沉积在晶体表面的原子可以 自发地向上扩散,从而在晶面上形成一些高于晶面的小山 丘. 在过去的实验中,也观察到过这类纳米量级小丘的出现, 当时都把它解释为由于基底晶格与沉积原子间的不匹配所 造成. 例如,将锗原子沉积在硅晶表面上,由于两种晶体间距 之间的差异会使表面发生变形,从而在晶体表面上生长出一 些像小茅屋似的晶丘. 现在科研组的科学家们提出了与上述 不同的看法:因为在沉积原子与基底原子完全相同的情况 下 同样可出现在沉积表面上形成晶丘. 他们将铝原子沉积 在铝晶表面 这时不存在任何晶格的变形 ,但通过扩散可以 在铝晶表面形成比沉积层高 10 倍的晶丘.

利用计算机模拟实验来研究这个晶体生长过程,发现在 晶体表面突出部位附近的沉积原子,可以跃迁向上达到晶丘 的顶部,有时一对原子可以相互改变位置并沿着晶丘斜面向 上攀登.这种现象在过去的沉积过程中常常是被忽视的.这 类与直觉相反的能形成纳米量级的晶丘的物理现象只能发 生在铝基底温度为 330K 到 500 K 之间.因此科学家们预 测,这种被我们忽视的向上扩散的过程与基底的温度有关. 在特定温度下,整个晶面上的相互作用距离会超过沉积层厚 度的 10 倍或更多.由此推断,这个现象对于薄膜生长和通过 分子束外延进行晶体生长都是极其重要的,而且在这个现象 的背后有着丰富的动力学生长的机理.

(云中客 摘自 Physical Review Letters, 4 July 2003)

## 更新型的扫描隧道显微镜

20 世纪重要的发明之一就是扫描隧道显微镜,简称为 STM. 它能对金属及其他导电表面给出原子水平上的形态结 构图. 最近美国科罗拉多矿学院的 P. Sutter 教授对 STM 设 计了一种新的技术 称之为"能量过滤 STM". 这项技术类似 于在普通显微镜上加一个"颜色滤波片",使我们能方便地 在摄影时分辨出想要寻找的特征. 同时",能量过滤 STM"也 使我们能容易地区分出一些具有相似化学性质的原子,这类 原子用其他手段常常很难分辨."能量过滤 STM"还能确认 在表面上的各种类别的化学键.

一般的 STM 是使用一个金属的探针,它对导电表面上 的高能电子非常敏感,当高能电子跃迁或隧穿到探针后,就 能为科学家们提供表面形态结构的各种数据并形成图像.但 由于它"偏爱"处于高能态的电子,就不能清晰地给出低能 电子的状态,而各种不同的化学键或不同类型的原子常常是 处于低能态的.为了解决这个问题"能量过滤 STM"采用砷 化铟半导体作为探针的材料.凡是半导体都具有一个电子不 能占有的能量范围 称之为"基本带隙".当半导体探针非常 接近导体表面时,在沿着探针轴处会出现一个能量禁区范 围 称之为"投射间隙(projected gap)",这个间隙将阻止某 些能量范围的电子隧穿到探针.调节探针与样品表面间的电 压,就能变动"投射间隙",从而可阻塞一些表面上的高能电 子,而使探针能对表面上处于低能态的电子产生感应.做实 验时可随意变动能量的禁区范围,就能获得导体表面上各种 化学键的信息,还可以从大量数据中去分析与比较各类化学 键的作用.现在这项技术已应用在由相似元素组成的合金表 面上,对它进行逐个原子的映射,因为这是薄膜生长中的一 项重要工艺,它常常涉及到纳米尺度上的变异.

(云中客 摘自 Physical Review Letters, 25 April 2003)